

Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für Breitband-, NF- und HF-Verstärker sowie mittelschnelle Schaltstufen

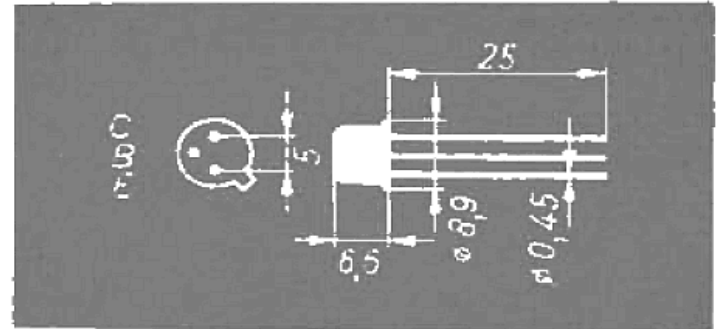
SF 022*

Abmessungen: Bauform B 3/25 - 3a,
TGL 11 811

Kollektor am Gehäuse
Masse ≈ 1 g

Zulässige Höchstwerte bis ϑ_{jmax}

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| $U_{CBO} = 33$ V | $P_{tot} = 600$ mW |
| $U_{CER} = 33$ V | bei $\vartheta_a = 25$ °C |
| bei $R_{BE} = 10$ Ω | $P_{tot} = 2,5$ W |
| $U_{EBO} = 5$ V | bei $\vartheta_c = 25$ °C |
| $I_C = 500$ mA | $\vartheta_j = +175$ °C |
| $I_B = 250$ mA | $\vartheta_s = -40$ °C... +150 °C |
| $\vartheta_{a min} = -40$ °C | |



Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 250 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$
 $R_{thjc} \leq 60 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

Kennwerte für $\vartheta_a = 25$ °C -5 grad

| Min. | Typ | Max. | Meßbedingungen | Stromverstärkungsgruppen |
|-----------------------------------|--------|-----------|---|--------------------------|
| Restströme | | | | |
| I_{CBO} | | 100 nA | $U_{CB} = 33$ V | |
| I_{EBO} | | 1 μ A | $U_{EB} = 5$ V | |
| Kollektor-Emitter-Spannung | | | | |
| U_{CER} | 33 V | | $I_C = 1$ mA, $R_{BE} = 10$ Ω | |
| Sättigungsspannung | | | | |
| U_{CEsat} | | 1 V | $I_C = 50$ mA, $I_B = 5$ mA | |
| Übergangsfrequenz | | | | |
| f_T | 60 MHz | | $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 10$ mA, $f = 15$ MHz | |
| Gleichstromverstärkung | | | | |
| B | 18 | 35 | | A |
| | 28 | 71 | | B |
| | 56 | 140 | | C |
| | 112 | 280 | | D |
| | 224 | 560 | | E |
| | 450 | 1120 | | F |

* Nicht für Neuentwicklungen